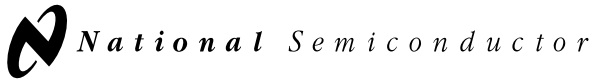


ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。

参考資料



April 1995

LM1972

μPot™ 2チャンネル78dB オーディオアッテネータ (ミュート機能付き)

概要

LM1972は、デジタル制御型2チャンネル・78dBのCMOSオーディオアッテネータです。各チャンネルは、0dB ~ 47.5dBの範囲で0.5dBステップ、48dB ~ 78dB範囲で1.0dBステップの減衰が可能であり、減衰量104dBのミュート機能も内蔵しています。この対数減衰ステップは、アプリケーションに合わせてソフトウェアにより調整することができます。

μPotの性能は、その優れたS/N比、極めて低い全高調波歪み+ノイズ(THD+N)そして、高精度のチャンネル・セパレーション特性により実証されています。μPotは、入力信号を出力信号から分離するミュート機能を備え、96dB以上の減衰量が得られます。また、減衰量の設定を変更してもポップ音が生じることはありません。

LM1972はTTL/CMOSコンパチブルの3線シリアル・インタフェースを介し、チャンネル選択用と減衰レベル設定用のデータを受信します。内蔵のデータ出力ピンを介して複数のμPotをデジチーチェーン接続することにより、アプリケーションに合わせてイネーブル・ライン/データ・ライン数を削減することができます。

主な仕様

全高調波歪み+ノイズ	0.003% (最大)
周波数特性	100kHz (-3dB) (最小)
減衰範囲 (ミュートを除く)	78dB (代表値)
減衰誤差	±0.25dB (最大)
SN比 (4Vrmsを基準)	110dB (最小)
チャンネル・セパレーション	100dB (最小)

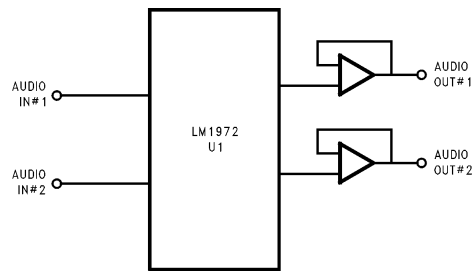
特長

- 3線シリアル・インタフェース
- デジチーチェーン接続が可能
- 減衰量104dBのミュート機能
- 減衰量変更によるポップ/クリック音を生じない

アプリケーション

- スタジオ用自動ミキシング・コンソール
- 音楽再生システム
- 音響効果システム
- 電子音楽(MIDI)
- パーソナル・コンピュータによるオーディオ制御

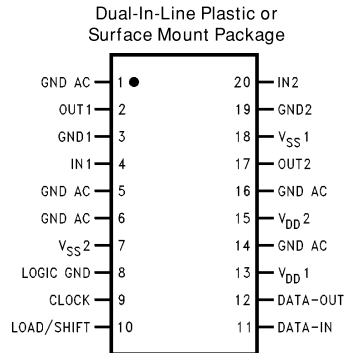
Typical Application



TL/H/11978-1

FIGURE 1. Typical Audio Attenuator Application Circuit

Connection Diagram



TL/H/11978-2

Top View

Order Number LM1972M or LM1972N
See NS Package Number M20B or N20A

μPot™およびOverture™はナショナルセミコンダクター社の商標です。

絶対最大定格 (Note 1, 2)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
 関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

電源電圧 ($V_{DD} - V_{SS}$)	15V
全てのピン電圧	$V_{SS} - 0.2V \sim V_{DD} + 0.2V$
消費電力 (Note 3)	150mW
ESD 耐圧 (Note 4)	2000V
接合部温度	150
ハンダ付け条件	
N パッケージ (10 秒)	+ 260
保存温度範囲	- 65 ~ + 150

動作条件 (Note 1, 2)

温度範囲	T_{MIN} T_A T_{MAX}	0 T_A + 70
電源電圧 ($V_{DD} - V_{SS}$)		4.5V ~ 12V

電気的特性 (Note 1, 2)

特記のない限り、以下の規格値は $V_{DD} = +6V$, $V_{SS} = -6V$, $V_{IN} = 5.5V_{pk}$, $f = 1kHz$ の条件で全チャンネルに対して適用されます。リミット値は $T_A = +25$ に対して適用され、デジタル入力は TTL/CMOS コンパチブルです。

Symbol	Parameter	Conditions	LM1972		Units (Limits)
			Typical (Note 5)	Limit (Note 6)	
I_S	Supply Current	Inputs are AC Grounded	2	4	mA (max)
THD+ N	Total Harmonic Distortion plus Noise	$V_{IN} = 0.5 V_{pk}$ @ 0dB Attenuation	0.0008	0.003	% (max)
XTalk	Crosstalk (Channel Separation)	0dB Attenuation for V_{IN} V_{CH} measured @ -78dB	110	100	dB (min)
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Inputs are AC Grounded @ -12dB Attenuation A-Weighted	120	110	dB (min)
A_M	Mute Attenuation		104	96	dB (min)
	Attenuation Step Size Error	0dB to -47.5dB -48dB to -78dB		± 0.05 ± 0.25	dB (max) dB (max)
	Absolute Attenuation Error	Attenuation @ 0dB	0.03	0.5	dB (min)
		Attenuation @ -20dB	19.8	19.0	dB (min)
		Attenuation @ -40dB	39.5	39.0	dB (min)
Attenuation @ -60dB		59.3	57.5	dB (min)	
	Attenuation @ -78dB	76.3	74.5	dB (min)	
	Channel-to-Channel Attenuation Tracking Error	Attenuation @ 0dB, -20dB, -40dB, -60dB Attenuation @ -78dB		± 0.5 ± 0.75	dB (max) dB (max)
I_{LEAK}	Analog Input Leakage Current	Inputs are AC Grounded	10.0	100	nA (max)

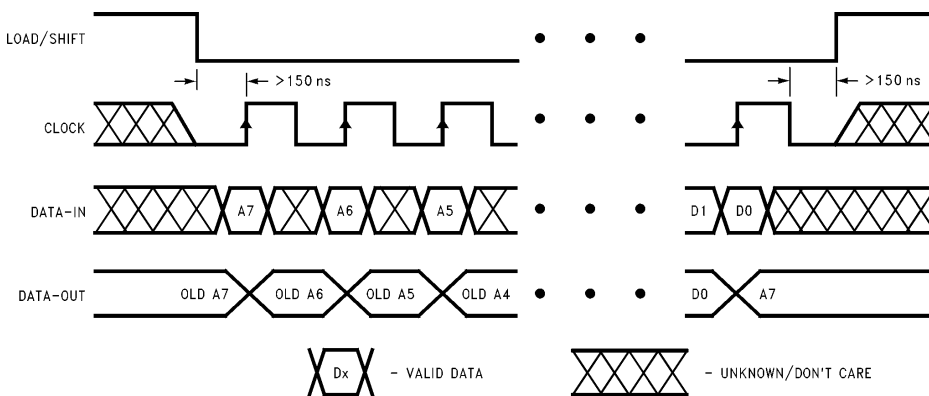


FIGURE 2. Timing Diagram

TL/ H/ 11978-3

電気的特性 (Note 1、2)(つづき)

特記のない限り、以下の規格値は $V_{DD} = +6V$ 、 $V_{SS} = -6V$ 、 $V_{IN} = 5.5V_{pk}$ 、 $f = 1kHz$ の条件で全チャネルに対して適用されます。リミット値は $T_A = +25$ に対して適用され、デジタル入力は TTL/CMOS コンパチブルです。

Symbol	Parameter	Conditions	LM1972		Units (Limits)
			Typical (Note 5)	Limit (Note 6)	
R_{IN}	AC Input Impedance	Pins 4, 20, $V_{IN} = 1.0 V_{pk}$, $f = 1 kHz$	40	20 60	k Ω (min) k Ω (max)
I_{IN}	Input Current	@ Pins 9, 10, 11 @ $0V < V_{IN} < 5V$	1.0	± 100	nA (max)
f_{CLK}	Clock Frequency		3	2	MHz (max)
V_{IH}	High-Level Input Voltage	@ Pins 9, 10, 11		2.0	V (min)
V_{IL}	Low-Level Input Voltage	@ Pins 9, 10, 11		0.8	V (max)
	Data-Out Levels (Pin 12)	$V_{DD} = 6V$, $V_{SS} = 0V$		0.1 5.9	V (max) V (min)

Note 1: 特記のない限り、全電圧は GND 端子 (1、3、5、6、14、16、19) を基準にして測定されます。

Note 2: 「絶対最大定格」とは、デバイスに破壊が発生する可能性のあるリミット値をいいます。「動作条件」とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値を保証するものではありません。「電気的特性」とは、特定の性能リミット値を保証する特別な試験条件での AC および DC の電気的仕様を示します。この場合、デバイスが「動作条件」の範囲にあるものとします。リミット値 (Limit) が記載されていないパラメータの仕様は保証されませんが、代表値 (Typical) はデバイス性能を示す目安になります。

Note 3: 温度上昇時の動作では、最大消費電力の定格を T_{JMAX} (最大接合部温度) θ_{JA} (接合部・周囲温度間熱抵抗) および T_A (周囲温度) に従って下げなければなりません。最大許容消費電力は $PD = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$ または絶対最大定格で示される値のうち、いずれが低い方の値です。LM1972 の場合、 T_{JMAX} は +150、基板実装時における θ_{JA} は 65 /W です。

Note 4: 使用した試験回路は、人体モデルに基づき、直列抵抗 1.5k Ω と 100pF のコンデンサから成る回路を使用し各端子に放電させます。

Note 5: 代表値 (Typical) は、 $T_A = +25$ で得られる最も標準的な値です。

Note 6: リミット値 (Limit) は、ナショナル セミコンダクター社の AOQL (平均出荷品質レベル) に基づき保証されます。

端子説明

信号グランド (3、19): 各入力専用の独立したグランド (GND1、GND2)。

信号入力 (4、20): 2つの独立した信号入力ピン (IN1、IN2)。

信号出力 (2、17): 2つの独立した信号出力ピン (OUT1、OUT2)。

電源 (13、15): 正電源ピン (V_{DD1} 、 V_{DD2})。

電源 (7、18): 負電源ピン (V_{SS1} 、 V_{SS2})。単一電源構成の場合はグランドに接続。

ACグランド (1、5、6、14、16): ダイに接続されていない(ワイヤボンディングされていない)ピン。隣接ピン間における信号のクロストークを防ぐために、これらのピンのAC接地が必要です。例えば、ピン14をピン13、ピン15にテカッピングすることで、配線が容易になり最良の信号絶縁が行えます。

ロジック・グランド (8): インタフェース・ライン(クロック、ロード/シフト、データ入力、データ出力)用のデジタル信号グランド。

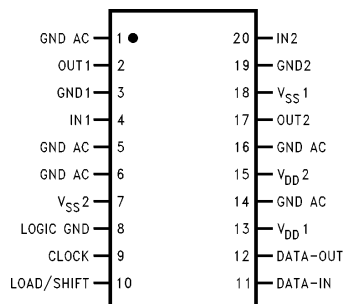
クロック (9): TTL/CMOS レベル・コンパチブルのクロック入力ピン。入力クロックの立上がりエッジで、このピンからデータが内部のシフトレジスタにロードされます。

ロード/シフト (10): TTL/CMOS レベル・コンパチブルのロード/シフト入力ピン。デバイスのイネーブル・ピンとして働き、この入力がLowレベル(0V)の間、クロックに同期してデータが取り込まれます。

データ入力 (11): TTL/CMOS レベル・コンパチブルのデータ入力ピン。マイクロ・コントローラからのシリアル・データはこのピンを介して取り込まれ、チャンネルの減衰レベルを変更するためにラッチ/デコードされます。

データ出力 (12): 同一データ・ラインで複数の μ Potを制御するデジタイゼーション・モード用ピン。マイクロ・コントローラからデジタイゼーションにデータが入力されると、シフトレジスタ内の先行データはデータ出力ピンからチェーンの次段 μ Potにシフトアウトされます(チェーンの最終 μ Potであればグランドにシフトアウト)。ロード/シフト・ラインは、新しいデータがすべて個々のレジスタにシフトインした後にHighにセットします。

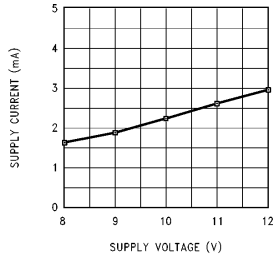
Connection Diagram



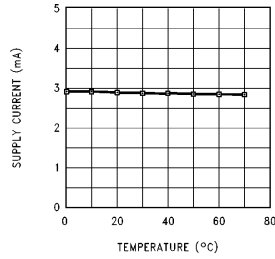
TL/H/11978-4

Typical Performance Characteristics

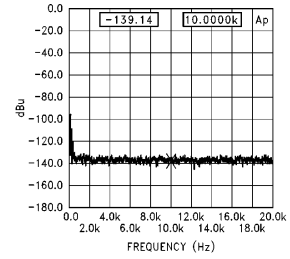
Supply Current vs Supply Voltage



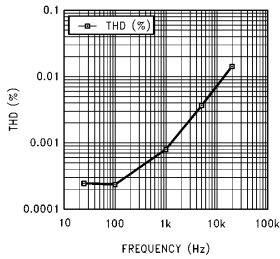
Supply Current vs Temperature



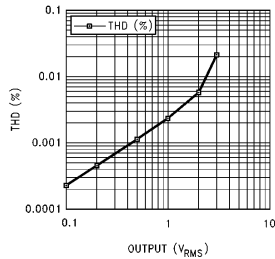
Noise Floor Spectrum by FFT Amplitude vs Frequency



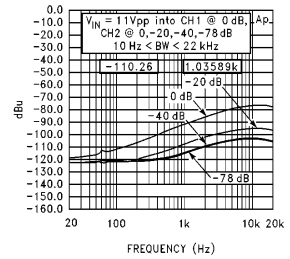
THD vs Freq by FFT $V_{DD} - V_{SS} = 12V$



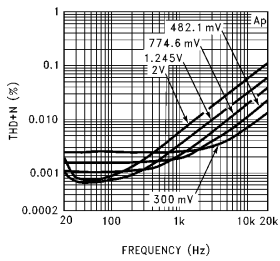
THD vs V_{OUT} at 1 KHz by FFT $V_{DD} - V_{SS} = 12V$



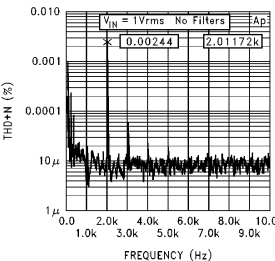
Crosstalk Test



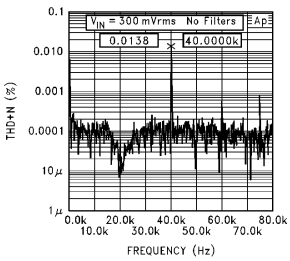
THD + N vs Frequency and Amplitude



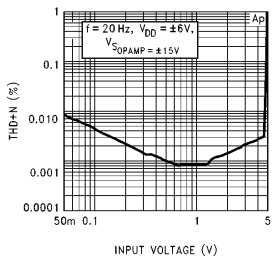
FFT of 1 kHz THD



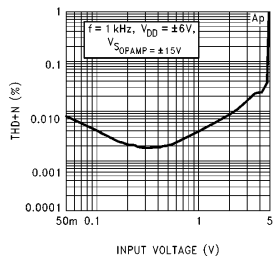
FFT of 20 kHz THD



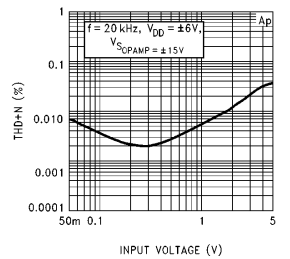
THD + N vs Amplitude



THD + N vs Amplitude



THD + N vs Amplitude



TL/H/11978-5

アプリケーション情報

減衰ステップの構成

Fig. 3 に LM1972 μ Pot の基本的な減衰ステップ特性曲線を示します。この減衰ステップは、アプリケーションに応じてソフトウェアで変更可能です。例えば、Fig. 4 に示すように、1dB 刻みの一定したステップ幅で対数的に減衰を行うことも可能です。減衰ステップをカスタマイズするうえで、各減衰レベル (dB) とデータ・ビット値を対応させることが必要となります (Table I 参照)。デバイスの減衰レベルは、チャンネル・アドレスが認識された場合に限り変更されます。チャンネル・アドレスが認識されると、Table I のデータ・ビットに対応する減衰レベルに変更されます。LM1972 は、モノラル信号を左右のチャンネルに分離するパンニング制御回路として構成することもできます (Fig. 6 参照)。この回路では LM1972 の基本的な減衰ステップを用いるか、Fig. 4 に示すように 1dB の一定したステップ幅で対数減衰を行うようにプログラムすることも可能です。

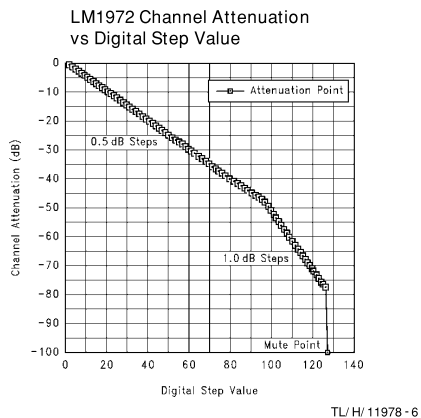


FIGURE 3. LM1972 Attenuation Step Scheme

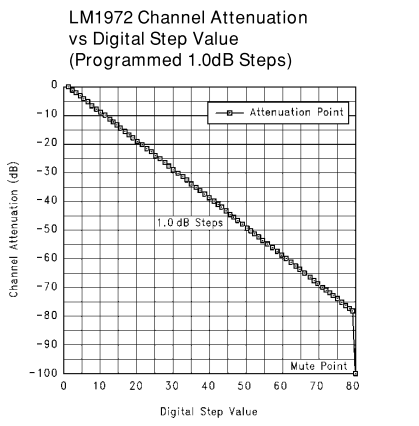


FIGURE 4. LM1972 1.0dB Attenuation Step Scheme

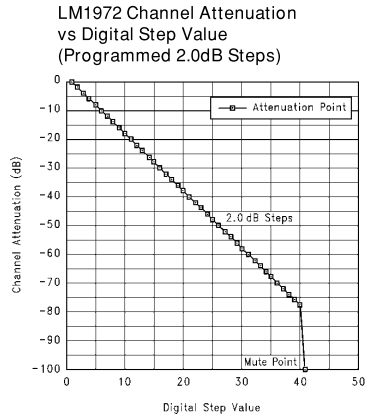


FIGURE 5. LM1972 2.0dB Attenuation Step Scheme

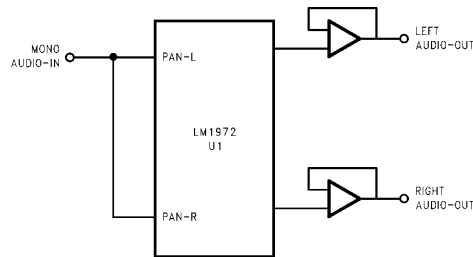


FIGURE 6. Mono Panning Circuit

入力インピーダンス

μ Pot の入力インピーダンスは、 $40k\Omega$ (標準) で一定です。通常、不要な DC 成分がデバイス内に伝搬するのを防ぐために、 $1\mu F$ の入力カップリング・コンデンサを付加しますが、前段の DC オフセットが無視できる程度であれば、このコンデンサは必要ありません。ただし、高性能システムの場合は、入力カップリング・コンデンサの使用を推奨します。

出力インピーダンス

μ Pot の出力インピーダンスは通常、 $25k\Omega \sim 35k\Omega$ の範囲で減衰ステップの変化とともに非線形的に変化します。これは、 μ Pot が対数的な減衰特性をもつ抵抗ラダー・ネットワーク回路から構成されているためです。したがって、 μ Pot は線形的なポテンショメータとしてではなく、対数アッテネータとしてみなすことができます。

μ Pot の直線性の測定にはバッファが必要です。これは、ほとんどの測定システムの場合、入力インピーダンスが高くなく、必要な測定精度が得られないためです。測定システムの入力インピーダンスが低いと、 μ Pot の出力に負荷がかかり、測定結果は不正確になります。こうした負荷の影響を防ぐために、バッファ/アンプとして JFET 入力オペアンプを使用して下さい。この場合、 μ Pot の性能は、外付けのバッファ/アンプの性能にのみ影響されます。

アプリケーション情報(つづき)

ミュート機能

μ Potの大きな特長の一つは、入力信号を104dB減衰するミュート機能を内蔵していることです (Fig. 3 参照)。これは、出力を入力から物理的に切り離すと同時に、約2k Ω の抵抗を介して出力ピンを接地することで実現しています。

ミュート機能は、デバイスの電源投入時に、または、0111 1111 ~ 1111 1111までのバイナリ・データがデバイスにシリアル転送された時に実行されます。これらのバイナリ・データが送られると、デバイスはそれまで設定されていた減衰動作からミュート動作に移行します。したがって、ミュート・ボタンをシステムに装備すれば、そのボタンを押すことにより、マイクロ・コントローラから μ Potに該当データを送り、一方のチャネルまたは両チャネルをミュートさせることが可能になります。この機能はソフトウェアで行うため、システム構成において大幅な柔軟性が得られます。

DC 入力

μ Potはオーディオ帯域信号用のアッテネータとして設計されていますが、入力DC電圧のトラッキングも可能です。このデバイスでは、各電源電圧から1ダイオード・ドロップ分までのDC電圧をトラッキングすることができます。

μ Potの出力段にバッファを用いた場合、DCトラッキングの能力は μ Potの出力バッファのゲイン構成と電源電圧によって決まることに注意して下さい。さらに、出力バッファの電源電圧は μ Potの電源電圧と同じにする必要がなく、電源電圧を上げてDCトラッキングの能力を高めることも可能です。

シリアルデータ・フォーマット

LM1972は、マイクロ・コントローラによる制御が容易な3線式のシリアル・インタフェースを採用しています。Fig. 2に、その3線信号(データ入力、クロック、ロード/シフト)のタイミング図を示します。Fig. 8のプロック図は、デジタル・インタフェースを介してタップ・スイッチを制御し、所定の減衰レベルを選択する構成を示しています。Fig. 2のタイミング図に示されるように、ロード/シフト・ラインは、最初のクロック・パルスの立ち上がりエッジよりも最低150ns前にLowにし、16データ・ビットのすべてが転送されるまでLow状態に保持する必要があります。シリアル・データはチャネル選択用の8ビットと、それに続く減衰量設定用の8ビットから構成され、いずれも最初にMSBから転送します。8ビットの減衰量設定データに先き立ち、8ビットのアドレス・データを転送します。Fig. 7にシリアル・データ・フォーマットの転送プロセスを示します。

TABLE I. LM1972 Micropot Attenuator Register Set Description

MSB	LSB
Address Register (Byte 0)	
0000 0000	Channel 1
0000 0001	Channel 2
0000 0010	Channel 3
Data Register (Byte 1)	
Contents	Attenuation Level dB
0000 0000	0.0
0000 0001	0.5
0000 0010	1.0
0000 0011	1.5
.....	::
0001 1110	15.0
0001 1111	15.5
0010 0000	16.0
0010 0001	16.5
0010 0010	17.0
.....	::
0101 1110	47.0
0101 1111	47.5
0110 0000	48.0
0110 0001	49.0
0110 0010	50.0
.....	::
0111 1100	76.0
0111 1101	77.0
0111 1110	78.0
0111 1111	100.0 (Mute)
1000 0000	100.0 (Mute)
.....	::
1111 1110	100.0 (Mute)
1111 1111	100.0 (Mute)

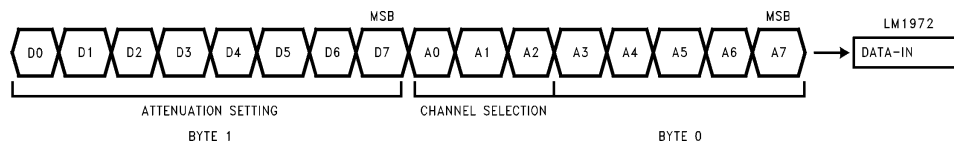


FIGURE 7. Serial Data Format Transfer Process

TL/H/11978-10

アプリケーション情報(つづき)

μPot のシステム・アーキテクチャ

μPot のデジタル・インタフェースは本質的にはシフトレジスタであり、このインタフェースを介し、シリアル・データのシフトイン、ラッチ、デコードが行われます。新しいデータがデータ入力ピンにシフトインされると、それより前のデータはデータ出力ピンからシフトアウトされます。データのシフトイン後に、ロード/シフト・ラインが High になり、新たなデータがラッチされます。次に、このデータはデコードされ、該当するタップ・スイッチが切り替わり、選択されたチャンネルは任意の減衰レベルに設定されます。このプロセスは、減衰量を変更する毎に繰り返されます。なお、各チャンネルの減衰レベルは、アッテネーションを変更するためにチャンネルを選択した時、またはμPot をパワーダウンして再度電源投入した時に限り更新されます。μPot を電源投入した時は、各チャンネルともミュート・モードになります。

μPot のラダー・アーキテクチャ

μPot の各チャンネルは、それぞれ独立した抵抗ラダー・ネットワーク回路により構成されています。Fig. 9 に示すように、このラダー回路は複数の R1/R2 抵抗素子から構成されており、減衰レベルの設定に使用されます。各素子に内蔵されている複数のタップ・スイッチにより、Table 1 のデータ・ビットに対応する減衰レベルが選択されます。Fig. 9 のラダー回路からわかるように、チャンネルの入カインピーダンスは選択されたタップ・スイッチに関係なく一定ですが、出カインピーダンスは選択されたタップ・スイッチによって変動します。

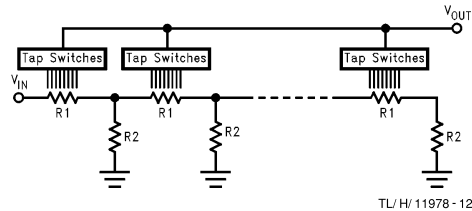


FIGURE 9. μPot Ladder Architecture

デジタル・ラインの信号レベル

μPot のデジタル・インタフェース部は、シフトレジスタの入力がダイオード・ドロップ分(約 1.4V)のスレッショルド電圧で動作するため、TTL または CMOS ロジック・コンパチブルとなっています。

デジタルデータ出力ピン

複数のμPot のデータ出力ピンを使用し、デジチェーンのシステム構成にすることができます。デジチェーン構成では、各チェーン当たりデータラインとロード/シフトラインがそれぞれ1本だけで済むため、プリント基板の配線パターンを簡素化できます。

データ出力ピンを使用しない場合はチャンネル間の分離を確実にし、信号ラインにデジタル・ノイズが乗らないように、2kΩの抵抗を介してデータ出力ピンを終端して下さい。このピンをフローティング状態にしておくこともできますが、データ出力ラインの信号ノイズが隣接ラインに乗ってノイズ特性が悪化することがあります。

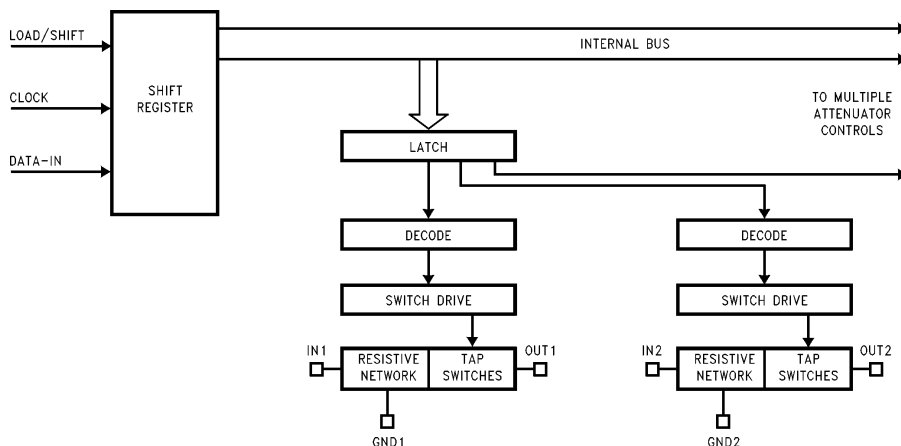


FIGURE 8. μPot System Architecture

TL/H/11978-11

アプリケーション情報(つづき)

デジチェーン機能

μ Pot のデジタル・インタフェースは基本的にシフトレジスタですから、同じデータ・ラインとロード/シフト・ラインで複数の μ Pot をプログラムすることができます。Fig. 10 に示すように、 n 個の μ Pot をデジチェーンで接続する場合、 $16n$ ビットがシフト、ロードされます。データのロード手順は、 μ Pot が 1 個の時と同じです。まず、ロード/シフト・ラインが Low になり、続いてデータがクロックに同期して順番に取り込まれ、同時に各 μ Pot にある先行データがデータ出力ピンからチェーンの後続 μ Pot にシフトアウトされて行きます(チェーンの最終 μ Pot ではグラウンドにシフトアウト)。この後、ロード/シフト・ラインが High になり、データはそれぞれ対応する μ Pot にラッチされます。データはアドレスに従ってデコードされ(チャンネルの選択)、減衰レベルの制御を行うタップ・スイッチが選択されます。

クロストークの測定

μ Pot のクロストーク(“Typical Performance Characteristics”の項を参照)は、片側チャンネルに信号を入力し、他チャンネルの同一周波数の出力レベルを測定して求めたものです。正確なクロストークを求めるためには、同じ周波数の信号レベルで測定することが重要です。また、測定精度を上げるために、 $1\mu\text{F}$ のコンデンサを介して測定チャンネル入力の AC 接地が必要です。

クリック/ポップの防止

ここでは、3 つの理由から出力バッファの必要性について説明します。これらの理由はシステム上すべて重要です。

第 1 に、 μ Pot の出力段にバッファ/アンプを付加することで、デバイスの減衰ステップ変更により生じる可聴クリック/ポップを確実に防止することができます。出力段にオンボードのバイポーラ・オペアンプを使用している場合、 μ Pot の出力インピーダンスの変化時に、このオペアンプの動作に一定量の DC バイアス電流が必要となり、DC 電圧の“ポップ”が発生します。すなわち、 μ Pot の出力インピーダンスが減衰ステップの変化に伴って変化すると、バイポーラ・アンプ動作に一定量の DC バイアス電流が必要になり、このポップ現象が起こります。DC 電圧の“ポップ”は出力インピーダンスが変化すると、DC バイアス電流も変化するため発生します。

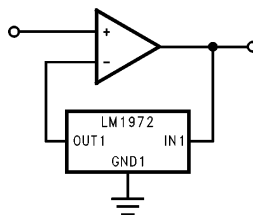
第 2 に、 μ Pot にドライブ機能がないため、バッファ/非反転アンプによりゲインを獲得しなければなりません。

第 3 に、 μ Pot の出力を高インピーダンスにし、負荷がかかるのと直線性誤差が生じるのを防ぐ必要があるためです。JFET 入力バッファを使用すれば、 μ Pot の出力段に高入力インピーダンスが得られるので、こうした問題は生じません。

クリックとポップは、LF412ACN などの JFET 入力バッファ/アンプを使用することで防止することができます。LF412 は高入力インピーダンスだけでなく、オーディオ帯域における低ノイズ・フロア、低 THD + N を特長としているため、システムでの信号状態と直線性を確保することができます。この方法では、システム全体の性能は JFET 入力バッファ/アンプの品質と性能によって決まります。

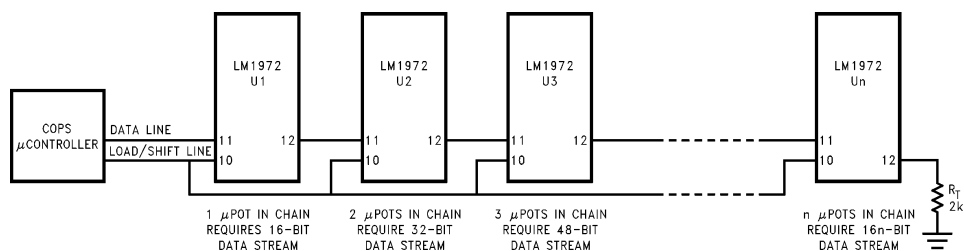
対数ゲイン・アンプ

μ Pot はアンプの帰還ループで使用することもできますが、この場合も、前述したように μ Pot の出力を高インピーダンスにし、その高精度の性能と直線性を確保する必要があります。同様に、出力に負荷がかかると減衰量の値も変化します。対数ゲイン・アンプを形成する場合は、Fig. 11 に示すように μ Pot を用いて帰還ループを構成します。この構成では、Table 1 に示した減衰レベルがゲイン・レベルとなり、最大 78dB の増幅が可能です。ほとんどのアプリケーションでは、ゲインを 78dB にすると信号クリッピングを生じますが、 μ Pot はプログラミングによりゲインの調整を行い、システムのクリッピング・レベルを回避することができます。なお、ミュート・モードでは、入力が出力から分離されることに注意して下さい。この構成でミュート・モードにすると、アンプがオープン・ループ・ゲイン状態になり、コンパレータの動作になります。こうした回路のプログラミングと設計には細心の注意が必要です。最大限の性能を得るためには、JFET 入力アンプを使用して下さい。



TL/H/11978-14

FIGURE 11. Digitally-Controlled Logarithmic Gain Amplifier Circuit

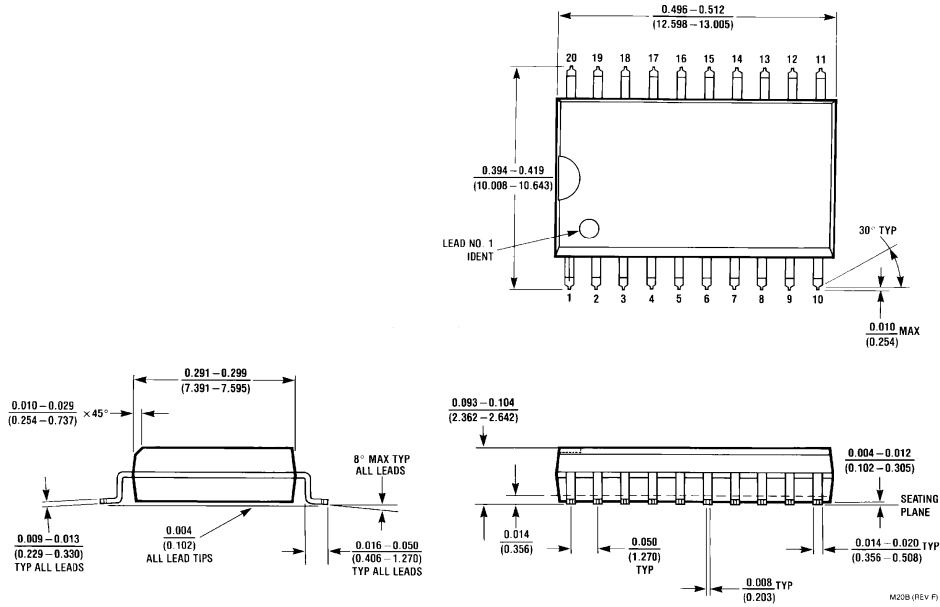


TL/H/11978-13

FIGURE 10. n - μ Pot Daisy-Chained Circuit

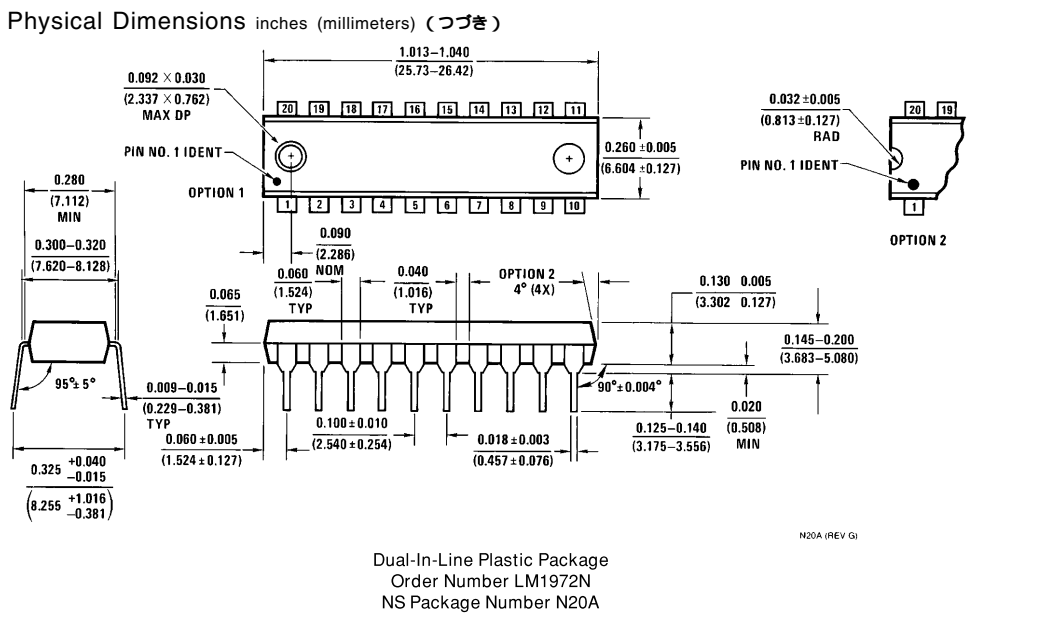
NOTE

Physical Dimensions inches (millimeters)



Surface Mount Package
 Order Number LM1972M
 NS Package Number M20B

M20B (REV F)



生命維持装置への使用について

弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用することはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。
2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本 社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300 <http://www.nsjk.co.jp/>

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポンス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。



0120-666-116



この紙は再生紙を使用しています